

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-150574

(P2000-150574A)

(43)公開日 平成12年5月30日 (2000.5.30)

(51)Int.Cl.

H 01 L 21/60

識別記号

3 1 1

F I

H 01 L 21/60

テ-コード (参考)

3 1 1 S 5 F 0 4 4

3 1 1 Q

21/92

6 0 2 H

審査請求 未請求 請求項の数 6 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平10-323197

(22)出願日

平成10年11月13日 (1998.11.13)

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号

(72)発明者 赤松 俊也

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(74)代理人 100091672

弁理士 岡本 啓三

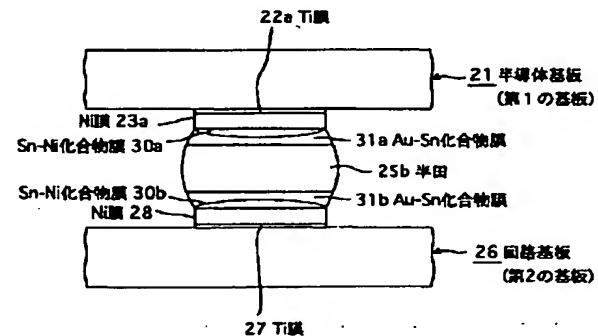
F ターム (参考) 5F044 KK04 LL04 QQ03 QQ04 QQ05

(54)【発明の名称】 半導体装置及び半田による接合方法

(57)【要約】

【課題】 電極への半田の濡れ性を確保するとともに、バリア層のNi i等の半田中への拡散を抑制して半田接合の機械的強度を向上させる。

【解決手段】 第1の基板21と第2の基板26にそれぞれ形成された少なくともNi i膜又はNi i合金膜23a, 28を有する電極同士がSn nを主成分とする半田25bにより接合されてなる半導体装置において、Ni i膜又はNi i合金膜23a, 28と半田25bとの間に半田25bと接するようにAu-Sn化合物膜31a, 31bが介在している。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の基板と第2の基板にそれぞれ形成された少なくともN_i膜又はN_i合金膜を有する電極同士がS_nを主成分とする半田により接合されてなる半導体装置において、

前記N_i膜又はN_i合金膜と前記半田との間に前記半田と接するようにA_u-S_n化合物膜が介在していることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 前記N_i膜又はN_i合金膜と前記A_u-S_n化合物膜の間にS_n-N_i化合物膜が介在していることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】 第1の基板上に少なくともN_i膜又はN_i合金膜と最上部のA_u膜とを有する多層の電極を形成する工程と、

第2の基板上に少なくともN_i膜又はN_i合金膜と最上部のA_u膜とを有する多層の電極を形成する工程と、前記第1の基板又は前記第2の基板のうち少なくともいすれかの前記電極のA_u膜上にS_nを主成分とする半田によりパンプを形成する工程と、

前記第1の基板又は前記第2の基板と前記電極形成面が向かい合うように対向させ、前記電極と前記パンプ又は前記パンプ同士を相互に接触させる工程と、

前記パンプを加熱し、溶融させて、前記A_uを前記半田中に含ませるとともに、前記電極同士を前記半田により接合させる工程と、

さらに加熱して、前記N_i膜又はN_i合金膜と前記半田との間に前記半田と接するA_u-S_n化合物膜を形成することを特徴とする半田による接合方法。

【請求項4】 第1の基板上に少なくともN_i膜又はN_i合金膜を有する電極を形成する工程と、

第2の基板上に少なくともN_i膜又はN_i合金膜を有する電極を形成する工程と、

前記第1の基板又は前記第2の基板のうち少なくともいすれかの前記電極の上にS_nを主成分とし、A_uを含有する半田によりパンプを形成する工程と、

前記第1の基板又は前記第2の基板と前記電極形成面が向かい合うように対向させ、前記電極と前記パンプ又は前記パンプ同士を相互に接触させる工程と、

前記パンプを加熱し、溶融させて前記電極同士を前記半田により接合させる工程と、

さらに加熱して、前記N_i膜又はN_i合金膜と前記半田との間に前記半田と接するA_u-S_n化合物膜を形成することを特徴とする半田による接合方法。

【請求項5】 前記A_u-S_n化合物膜を形成する加熱温度は、前記半田の溶融温度よりも低いことを特徴とする請求項3又は4に記載の半田による接合方法。

【請求項6】 前記N_i膜又はN_i合金膜と前記A_u-S_n化合物膜の間にS_n-N_i化合物膜が形成されることを特徴とする請求項4乃至5のいすれかに記載の半田による接合方法。

【発明の詳細な説明】

本発明は、半導体装置及び半田による接合方法に関し、より詳しくは、S_nを主成分とする半田のパンプを用いて電子部品と回路基板とを接続する半導体装置及び半田による接合方法に関する。

【0001】

【従来の技術】電子機器部品は半田によって接合される部分が大多数である。接合に用いられる半田では、一般的の電子部品ではS_n-Pb共晶半田(溶融温度183℃)が広く用いられている。

【0002】一方、接合に用いられる半田では、Pbに5%のS_nが添加された溶融温度314℃の半田(以下、Pb-5S_nと称し、類似の表示はこれと同じような内容を表す。)が知られている。LSIや回路基板上の配線は一般的にA1が用いられており、このような半田を用いてA1配線との接合を行おうとすると、半田が弾かれてA1配線の上に直接半田付けすることはできない。このため、A1配線との密着性を高めるための密着層と、半田が拡散しないためのバリア層と、半田に漏れやすい金属からなる漏れ性向上層とが積層された電極を形成し、このような構成の電極上に半田付けを行って他の電極との接合を形成している。この場合、高い接合強度を得るための電極材料及び電極の積層構造を必要とする。

【0003】現状のS_n-Pb系半田では密着層にTi, Crを用い、バリア層にCu, Niを用い、漏れ性向上層にAu, Ag, Pd等を用いている。

【0004】また、現在LSIの実装方法として主流となっているフリップチップ実装では、半田パンプをLSIチップの活性領域にアレイ状に配置するため、半田材料中のPbから発生するα線によりソフトエラーが起こるという問題がある。特に、素子の微細化、低電圧化が進行するにしたがってソフトエラーが増大し、問題となっている。

【0005】また、環境問題の点からもPbを含まない半田材料が要求され、S_nを主成分とする半田の開発が盛んに行われている。

【0006】しかしながら、S_nを主成分とする半田によりパンプ接合する際に、Pb-5S_n半田と比較してS_n成分が多いため、Pb-5S_n半田で使用する電極構成では、パンプ形成工程で、電極上に形成した半田パンプを融点以上に加熱して溶融させたときに、バリア層の役割をするN_iが半田中に拡散してN_i膜の膜厚が減少し、半田がN_i膜の下地の金属膜と接触するようになる。このとき、半田が下地の金属膜に弾かれて、半田パンプの欠落や接合強度の低下等の接合不良が多く発生することが分かった。

【0007】また、N_i膜やCu膜の膜厚を厚くして上記不具合を防止しようとした場合、S_nを主成分とする半田中へのN_i等の拡散は速く、パンプ形成工程で半

田中に多量のNi等が拡散し、Snと金属間化合物を形成する。このため、半田の機械的強度が低下し、接合部の信頼性を著しく低下させることができた。

【0008】また、熱サイクル試験等の熱負荷によって、バリア層のNi等が半田中に拡散して電極面積を減少させ、信頼性を低下させることも分かった。

【0009】さらに、一般の電子機器の電極表面層には、酸化防止膜としてAuが多く用いられている。AuはSnを主成分とする半田、例えばPb-63Sn半田中に拡散しやすいため、Auの膜厚が厚いと半田中に溶け込むAuの量が多くなり、Au-Sn金属間化合物によって半田の機械的強度が低下し、寿命が短くなる。

【0010】そこで、特開平3-66492号公報ではSn-Ag系半田を用いて接合を形成する方法が開示されており、Auが半田中に拡散して反応しても、Agの作用によりAu-Sn金属間化合物を半田中に分散させて機械的強度が低下しないようにしている。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】しかし、Sn-Ag系半田を用いた場合、フリップチップ実装などのようにLSIチップの電極と回路基板の電極との間のギャップが100μm以下になると、半田部分が少なくなつて半田の応力緩和効果が小さくなり、電極部分にかかる応力が大きくなる。しかも、バリア層の金属の拡散によって半田が喰われ、半田と電極との接続面積が減少してくるとその影響はますます大きくなる。このため、半田接合が剥がれやすくなり、信頼性が低下する。

【0012】また、濡れ性向上層のAu膜は酸化防止効果と半田中への拡散量との兼ね合いを考慮し、さらに最低限濡れ性を確保できるような膜厚でよいため、その膜厚を0.1μm以下と薄くしていることが多い。この場合、半田付け時の濡れ性不良がでないように、半田付け時間を長くして半田付け温度も従来よりも高温で行うようにしている。このため、Snを主成分とする半田を使用し、Ni膜やNi合金膜をバリア層とする場合には、バリア層のNiが半田中に多量に拡散し、このため半田接合の機械的強度を弱め、信頼性を低下させている。

【0013】本発明は、上記の従来例の問題点に鑑みて創作されたものであり、電極への半田の濡れ性を確保するとともに、バリア層のNi等の半田中への拡散を抑制して半田接合の機械的強度を向上させることができる半導体装置及び半田による接合方法を提供するものである。

【0014】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、請求項1の発明は半導体装置に係り、第1の基板と第2の基板にそれぞれ形成された少なくともNi膜又はNi合金膜を有する電極同士がSnを主成分とする半田により接合されてなる半導体装置において、前記Ni膜又はNi合金膜と前記半田との間に前記半田と接するよ

うにAu-Sn化合物層が介在していることを特徴としている。

【0015】請求項2に係る発明は請求項1記載の半導体装置に係り、前記半田中のSnの含有量が80wt%以上であることを特徴としている。

【0016】請求項3に係る発明は請求項1又は2に記載の半導体装置に係り、前記Ni膜又はNi合金膜と前記Au-Sn化合物膜の間にSn-Ni化合物膜が介在していることを特徴としている。

【0017】請求項4に係る発明は半田による接合方法に係り、第1の基板上に少なくともNi膜又はNi合金膜と最上部のAu膜とを有する多層の電極を形成する工程と、第2の基板上に少なくともNi膜又はNi合金膜と最上部のAu膜とを有する多層の電極を形成する工程と、前記第1の基板又は前記第2の基板のうち少なくともいずれかの前記電極のAu膜上にSnを主成分とする半田によりバンプを形成する工程と、前記第1の基板又は前記第2の基板とを前記電極形成面が向かい合うように対向させ、前記電極と前記バンプ又は前記バンプ同士を相互に接触させる工程と、前記バンプを加熱し、溶融させて、前記Auを前記半田中に含ませるとともに、前記電極同士を前記半田により接合させる工程と、さらに加熱して、前記Ni膜又はNi合金膜と前記半田との間に前記半田と接するAu-Sn化合物層を形成することを特徴としている。

【0018】請求項5に係る発明は半田による接合方法に係り、第1の基板上に少なくともNi膜又はNi合金膜を有する電極を形成する工程と、第2の基板上に少なくともNi膜又はNi合金膜を有する電極を形成する工程と、前記第1の基板又は前記第2の基板のうち少なくともいずれか一の前記電極の上にSnを主成分とし、Auを含有する半田によりバンプを形成する工程と、前記第1の基板又は前記第2の基板とを前記電極形成面が向かい合うように対向させ、前記電極と前記バンプ又は前記バンプ同士を相互に接触させる工程と、前記バンプを加熱し、溶融させて前記電極同士を前記半田により接合させる工程と、さらに加熱して、前記Ni膜又はNi合金膜と前記半田との間に前記半田と接するAu-Sn化合物層を形成することを特徴としている。

【0019】請求項6の発明は請求項4又は5に記載の半田による接合方法に係り、前記半田中のSnの含有量が80wt%以上であることを特徴としている。

【0020】請求項7の発明は請求項4乃至6のいずれか一に記載の半田による接合方法に係り、前記電極同士を前記半田により接合したときの前記半田中のAuの含有量が0.1wt%以上、20wt%以下であることを特徴としている。

【0021】請求項8の発明は請求項4乃至7のうちいずれか一に記載の半田による接合方法に係り、前記半田は、前記Snのほかに、Ag、Bi、Cu、In、N

i. Sb, 又はZnのうち少なくともいずれか一つを含むことを特徴としている。

【0022】請求項9の発明は請求項4乃至8うちのいずれか一に記載の半田による接合方法に係り、前記Au-Sn化合物層を形成する加熱温度は、前記半田の溶融温度よりも低いことを特徴とすることを特徴としている。

【0023】請求項10の発明は請求項4乃至9うちのいずれか一に記載の半田による接合方法に係り、前記Ni膜又はNi合金膜と前記Au-Sn化合物膜の間にSn-Ni化合物膜が形成されることを特徴としている。

【0024】ところで、Ni膜又はNiを含む合金膜とAu膜とを有する電極同士をSnを主成分とする半田で接合した場合、本願発明者によって以下のことを見いだされた。

【0025】即ち、電極の表面層の構成材料であるAuが半田中に拡散してAu-Sn化合物が形成され、半田中に分散する。一方、同じく電極の構成材料であるNiはAuと比較してSn含有半田中への拡散速度が遅いため、ほとんどは電極の直上でSn-Ni化合物を形成する。更に、分散したAu-Sn化合物は半田の融点以下の加熱によってSn-Ni化合物の周りに凝集する。また、Sn-Ni化合物の周りに凝集して形成されたAu-Sn化合物層はSnを主成分とする半田中へのNiの拡散を抑制する効果がある。

【0026】本発明の半導体装置は、第1の基板と第2の基板にそれぞれ形成された少なくともNi膜又はNi合金膜を有する電極同士がSnを主成分とする半田により接合され、Ni膜又はNi合金膜と半田との間に半田と接するようにAu-Sn化合物層を介在させている。

【0027】即ち、Ni膜又はNi合金膜と半田との間に介在するAu-Sn化合物層がNiの拡散を抑制する機能を有するため、Sn系半田中へのNiの拡散を抑制することができる。

【0028】また、本発明の半田接合の形成方法においては、Snを主成分とする半田を溶融して少なくともNi膜又はNiをふくむ合金膜と最上層のAu膜とを有する電極同士を接合し、さらに加熱してNi膜又はNiをふくむ合金膜と半田との間に半田と接するAu-Sn化合物層を形成している。

【0029】又は、電極の最上層にAu膜を用いない場合、或いはAu膜の膜厚が薄い場合には、Auを含有させたSnを主成分とする半田を用いている。

【0030】これらの場合いずれも、半田による接合を形成した後の半田中に含まれるAuの量が0.1wt%~20wt%程度になるように膜厚調整や含有量の調整を行うようにすることが好ましい。

【0031】これにより、半田による接合を形成した後電極中のNi膜等と半田の間、更には接合形成の際に電極の直上に形成されたSn-Ni化合物と半田との間に

Au-Sn化合物層を形成することができる。

【0032】即ち、Snを主成分とする半田への拡散速度の遅いNiを電極の構成材料として用いた場合、接合形成の際に電極の直上にSn-Ni化合物層が形成されるとともに、半田中にAu-Sn化合物が生成して分散する。そして、接合形成後半田の融点より低い温度でさらに加熱することにより、半田中に分散するAu-Sn化合物をSn-Ni化合物層の周辺に凝集させることができる。

【0033】このようにして、電極中のNi膜等と半田の間、更にはSn-Ni化合物層と半田の間にNiの拡散を抑制しうるAu-Sn化合物層を介在させることができるので、半田中へのNiの拡散を抑制し、電極面積の減少を防止することができる。

【0034】これによって、半田接合形成の工程中のパンプ欠け不良を減少でき、接合形成後も良好な接合状態を維持し、耐熱疲労寿命の向上を図ることができる。

【0035】また、Au-Sn化合物層と半田の界面に応力が集中するが、接合形成後の加熱時間を長くし、或いは半田中のAuの量を増やして厚いAu-Sn化合物層を形成することによって、半田接合への応力が集中する箇所を半田接合の中央部へとシフトさせることができる。このため、半田接合への応力を両基板に分散して緩和することができ、寿命を向上させる効果がある。

【0036】さらに、熱サイクル試験等の加熱によりAu-Sn化合物層の成長が促進されて厚いAu-Sn化合物層が形成されるため、半田中へのNi拡散をさらに抑制する効果が得られる。

【0037】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。

【0038】(第1の実施の形態) 図1~図3は、本発明の第1の実施の形態に係る半田による接合方法及びその方法により作成された半導体装置について示す断面図である。

【0039】それらの図のうち、図3は本発明の第1の実施の形態に係る半田による接合方法により作成された半導体装置について示す断面図である。

【0040】その半導体装置は、図3に示すように、窒化アルミニウム基板(AIN基板)或いはアルミナ基板上に図示しない接続電極や回路配線が形成された回路基板26と、図示しないトランジスタや配線や接続電極等からなる集積回路が形成された半導体基板21とが相互の接続電極等の形成面が対向するように積層され、それぞれの接続電極が半田25bで接合されている構成を有する。

【0041】この場合、半田25bの材料として錫(Sn)中に銀(Ag)が3.5wt%含有されたものが用いられている。

【0042】また、接合用の半田25bは半導体基板2

1上のNi膜23aを有する電極と回路基板26上のNi膜28を有する電極の間に形成され、さらに、各Ni膜23a及び28と半田25bとの間にそれぞれ少なくとも半田25bと接するようにAu-Sn化合物膜31a, 31bが形成されている構成を有している。

【0043】また、上記半導体装置を製造する場合、半田バンプを溶融して接合用の半田25bを形成する関係上、実際には、電極の直上にSn-Ni化合物膜30a, 30bが形成されるため、広くはNi膜23a, 28と接合用の半田25bとの間、狭くはSn-Ni化合物膜30a, 30bと接合用の半田25bとの間にAu-Sn化合物膜31a, 31bが介在することになる。

【0044】さらに、Ni膜23aと半導体基板21の間、Ni電極28と回路基板26との間にはそれぞれ密着層としてTi膜22a, 27が介在している。

【0045】次に、図1～図3を参照しながら上記半導体装置を作成する方法について説明する。

【0046】まず、図1(a)に示すように、トランジスタや配線等からなる集積回路が形成された半導体基板21上に密着層となる膜厚100nmのTi膜22をスパッタ法により形成し、メッキ法によりTi膜22上にバリア層となる膜厚2μmのNi膜23を形成し、その上に同じくメッキ法により濡れ性向上層となる膜厚700nmのAu膜24を形成する。

【0047】このとき、図5に示すように、Au膜24の膜厚は半田溶融時に半田中に含まれるようになるAuの含有量に影響を及ぼすため、注意を要する。なお、図5は半導体基板21と回路基板26間のギャップをパラメータとして半田溶融時の半田中のAu含有量について調査した結果を示すグラフであり、縦軸は線形目盛りで表した半田中のAu含有量(wt%)を示し、横軸は線形目盛りで表した電極最上層のAu膜厚(μm)を示す。

【0048】次いで、図1(b)に示すように、同じマスクを用いてAu膜24とNi膜23とTi膜22とをパターニングして、半田により接合されるべき直径100μmの電極を形成する。これにより、半導体基板21側から密着層のTi膜22aとバリア層のNi膜23aと濡れ性向上層のAu膜24aからなる多層の電極が形成される。

【0049】次に、図1(c)に示すように、半田バンプ25を半導体基板21の電極上に形成する。このような半田バンプの形成方法の一例として所謂ディンブルフレート法と称されるものがあり、その方法を図4(a), (b)に示す。

【0050】まず、Sn中に3.5wt%のAgを含む半田粉末とフラックススピヒクルとを9:1の比率で混合し、半田ペースト25cを作成する。

【0051】次いで、図4(a)に示すように、この半田ペースト25cを転写板51の凹部52に充填する。

続いて、図4(b)に示すように、半田の融点以上の温度になるように加熱して半田ペースト25cを溶融し、半田ボール25dを形成する。

【0052】この半田ボール25dに半導体基板21の電極を接触させて付着させ、電極上に半田バンプ25を形成する。形成された半田バンプ25の形状を整え、表面の酸化被膜を除去するため、半田バンプ25の表面にフラックスを塗布し、窒素中で半田の融点280℃以上の温度に加熱して溶融し、凝固させる。この状態を図1(c)に示す。

【0053】続いて、ダイサー等により半導体基板21を切断して平面形状が一辺13mmの正方形のチップに分離する。

【0054】次いで、半田バンプ25の表面にフラックスを塗布したのち、回路基板26の電極の上に半田バンプ25を位置合わせし、接触させる。回路基板26の電極は半導体基板21の電極と同じ構造を有し、下から密着層のTi膜27とバリア層のNi膜28と濡れ性向上層のAu膜29とが順に積層されてなる。図2(a)に示すように、回路基板26の電極の上に半導体基板21上の半田バンプ25を位置合わせし、接触させる。回路基板26の電極は半導体基板21の電極と同じ構造を有し、下から密着層のTi膜27とバリア層のNi膜28と濡れ性向上層のAu膜29とが順に積層されてなる。

【0055】次に、図2(b)に示すように、半田バンプ25を溶融温度よりも高い温度280℃に加熱して半田バンプ25を溶融させ、電極同士を半田25aにより接合する。このとき、半導体基板21表面と回路基板26表面との間のギャップは約60μmであった。従つて、図5より、半田中に含まれるAuの含有量は凡そ3%と推定される。

【0056】このとき、両電極の最上層のAu膜24a, 29からAuが半田25a中に拡散してSnと結合し、半田25a中に分散するAu-Sn化合物31が形成される。また、電極中からNiが半田25a中に拡散して半田25aとNi膜23a, 28との間にSn-Ni化合物膜30a, 30bが形成される。この場合、NiはSnを主成分とする半田25aへの拡散速度が遅いため、Sn-Ni化合物膜30a, 30bは電極の直上に形成される。

【0057】次いで、半田25aを窒素中で半田25aの融点よりも低い温度125℃で加熱する。これにより、半田25a中に分散するAu-Sn化合物31がSn-Ni化合物膜30a, 30bの近くに凝集してSn-Ni化合物膜30a, 30bと半田25bとの間にAu-Sn化合物膜31a, 31bが形成される。

【0058】これにより、半導体基板21と回路基板26にそれぞれ形成された電極同士がSnを主成分とする半田25bにより接合されて半導体基板21と回路基板26間が電気的に接続されてなる半導体装置が完成す

る。

【0059】次に、Au膜の膜厚以外上記の半導体装置と同じ構成を有する試験用試料を作成し、これらを用いて用いて熱サイクル試験を行った。

【0060】試験試料としてAu膜の膜厚を0μm(Au膜無し)、0.05、0.5、1.0μmと変えた4種類の半導体装置を作成した。他の条件は第1の実施の形態と同じである。

【0061】熱サイクル試験の試験条件は、-55°C→+125°C→-55°Cを一サイクルとして接合部分等が破断するまで何回か繰り返した。この場合、一サイクル中の各温度状態は30分間保持される。

【0062】その結果を表1に示す。

【0063】

【表1】

熱サイクル試験結果

試料	1	2	3	4
Au膜厚(μm)	0	0.05	0.5	1.0
サイクル寿命(サイクル)	200	200	400	500

注) 試験方法

-55°C (30分) → +125°C (30分) → -55°C (30分) を1サイクルとして抵抗増あるいは破断までのサイクルをカウントする。

【0064】表1によれば、Au膜無し、及び0.05μmの場合200サイクルで破断し、0.5μmの場合400サイクルで破断し、1.0μmの場合凡そ500サイクルまで破断もなく良好な接合状態が維持された。

【0065】以上のように、第1の実施の形態によれば、Snを主成分とする半田バンプ25を溶融して少なくともNi膜23a、28と最上層のAu膜24a、29とを有する電極同士を接合し、さらに加熱してNi膜23a、28と半田25bとの間に半田25bと接するAu-Sn化合物膜31a、31bを形成している。

【0066】即ち、広くは電極を構成するNi膜23a、28と半田25bの間、狭くは接合形成の際に電極の直上に形成されたSn-Ni化合物膜30a、30bと半田25bとの間にNiの拡散抑制効果を有するAu-Sn化合物層31a、31bを形成することができる。このため、半田25b中へのNiの拡散を抑制し、電極面積の減少を防止することができる。

【0067】これにより、半田による接合形成の工程中のバンプ欠け不良を減少でき、接合形成後も良好な接合状態を維持し、耐熱疲労寿命の向上を図ることができる。

【0068】なお、Au-Sn化合物膜31a、31bと半田25bの界面に応力が集中するが、接合形成後の

加熱時間を長くし、或いは半田25a中のAuの量を増やして厚いAu-Sn化合物膜31a、31bを形成することによって、半田25bへの応力が集中する箇所を半田25bの中央部へとシフトさせることができる。これにより、半田25bへの応力を両基板21、26に分散して緩和することができ、寿命を向上させる効果がある。

【0069】また、熱サイクル試験等の加熱によりAu-Sn化合物膜31a、31bの成長が促進されてより厚いAu-Sn化合物膜31a、31bが形成されるため、半田25b中へのNi拡散をさらに抑制する効果が得られる。

(第2の実施の形態) 次に、図6を参照しながら第1の実施の形態の半導体装置を作成する別の半田による接合方法について説明する。

【0070】第1の実施の形態と異なるところは、電極の最上層にAu膜を形成せずに、半田44中にAuを適量含有させている点である。

【0071】まず、図示しないトランジスタや配線等からなる集積回路が形成された半導体基板41上に密着層となる膜厚100nmのTi膜42をスパッタ法により形成し、メッキ法によりTi膜42上にバリア層となる膜厚4μmのNi膜43を形成する。

【0072】次いで、同じマスクを用いてNi膜43とTi膜42とをパターニングして、図6(a)に示すような、半田により接合される直径100μmの電極を形成する。

【0073】次に、Auを5wt%含むSn-3.5Agの半田粉末とフラックススピヒクリルとを9:1で混合して、半田ペーストを作成する。続いて、図4(a)、(b)に示すディンブルプレート法により、半田バンプ44を半導体基板21の電極上に形成する。形成された半田バンプ44の形状を整え、表面の酸化被膜を除去するため、半田バンプ44の表面にフラックスを塗布し、窒素中で半田の融点280°C以上の温度に加熱して溶融し、凝固させる。

【0074】次いで、半田バンプ44の表面にフラックスを塗布した後、回路基板45の電極の上に半導体基板41の半田バンプ44を位置合わせし、接触させる。なお、回路基板45の電極も半導体基板41の電極と同じくTi膜46とその上のNi膜47とから構成されている。

【0075】次に、半田バンプ44を窒素中で溶融温度よりも高い温度280°Cで加熱して半田バンプ44を溶融させ、半田により電極同士を接合する。このとき、図に示していないが、半田バンプ44中のAuがSnと結合し、半田中に分散するAu-Sn化合物が形成される。また、図6(b)に示すように、半田とNi膜43、47との間に介在するSn-Ni化合物膜48a、48bが形成される。

【0076】次いで、図6(b)に示すように、半田の融点よりも低い温度125°Cで半田を加熱し、所定の時間保持する。これにより、半田中に分散するAu-Sn化合物がSn-Ni化合物膜48a, 48bの近くに凝集してSn-Ni化合物膜48a, 48bと半田44aとの間にAu-Sn化合物層49a, 49bが形成される。

【0077】以上のようにして、半導体基板41と回路基板45にそれぞれ形成された電極同士がSnを主成分とする半田44aにより接合されて半導体基板41と回路基板45間に電気的に接続されてなる半導体装置が完成する。

【0078】この半導体装置について第1の実施の形態と同じ条件で熱サイクル試験を500サイクルまで行った結果、破断もなく良好な接合状態が保持されていた。

【0079】以上のように、第2の実施の形態によれば、電極の最上層にAu膜を形成せずSnを主成分とする半田44中にAuを含有させて、半田44aを溶融して電極同士を接合し、加熱している。

【0080】これにより、電極中のNi膜43, 47と半田の間、更には接合形成の際に電極の直上に生成したSn-Ni化合物膜48a, 48bと半田44aとの間にAu-Sn化合物膜49a, 49bを形成することができるので、半田44a中へのNiの拡散を抑制し、電極面積の減少を防止することができる。

【0081】これによって、半田接合形成の工程中のパンプ欠け不良を減少でき、接合形成後も良好な接合状態を維持し、耐熱疲労寿命の向上を図ることができる。なお、上記実施の形態により本願発明の具体的な形態について説明してきたが、上記実施の形態に限られるものではなく、上記実施の形態から導かれる設計変更程度の種々の変形例は本願発明の技術的範囲に含まれる。

【0082】例えば、第1の実施の形態では、半田パンプ25を溶融して電極同士を接合した後の半田25a中のAuの含有量を凡そ3wt%としているが、これに限られるものではなく、Au膜24aの膜厚や半田25bの高さ(ギャップ)を調整して半田25a中のAuの含有量を任意に調整してよいが、特に0.1wt%以上、20wt%以下の範囲が好ましい。

【0083】また、第2の実施の形態では、半田44中のAuの量、即ち半田により電極同士を接合したときの半田44中のAuの含有量を5wt%としているが、同じく半田44中のAuの含有量を任意に選択できる。特に0.1wt%以上、20wt%以下の範囲が好ましい。

【0084】さらに、第2の実施の形態では、電極の最上層にAu膜を形成しない場合について示しているが、Au膜の膜厚が薄い場合にも適用できる。この場合にも、当初の半田中のAuの含有量と半田溶融時に電極から半田中に拡散するAuの量を決める、Au膜厚、ギャ

ップ寸法、加熱条件等を調整して、半田と電極金属との接合を形成したときの半田中のAuの含有量を任意に調整することができるが、同じく0.1wt%以上、20wt%以下の範囲が好ましい。

【0085】また、第1及び第2の実施の形態では、半田パンプ25, 44を半導体基板21, 41側にのみ形成しているが、半導体基板21, 41側と回路基板26, 45側両方に形成してもよい。

【0086】さらに、第1及び第2の実施の形態では、半田はSnにAgを添加したものが用いられているが、Snに、Bi, Cu, In, Ni, Sb, 又はZnのうち少なくともいずれか一つを添加したものでもよい。

【0087】また、第1及び第2の実施の形態では、電極のバリア層の材料としてNiを用いた場合に本発明を適用しているが、Niを含む合金を用いた場合にも本発明を適用できる。

【0088】

【発明の効果】本発明によれば、Snを主成分とする半田を溶融して少なくともNi膜又はNiをふくむ合金膜と最上層のAu膜とを有する電極同士を接合し、さらに加熱してNi膜又はNiをふくむ合金膜と半田との間に半田と接するAu-Sn化合物層を形成している。

【0089】又は、電極の最上層にAu膜を用いない場合、或いはAu膜の膜厚が薄い場合には、Auを含有したSnを主成分とする半田を用いることを特徴としている。

【0090】従って、電極中のNi膜等と半田の間、或いは接合形成の際に電極の直上に形成されるSn-Ni化合物と半田との間にNiの拡散阻止効果を有するAu-Sn化合物層が形成されるので、半田中へのNiの拡散を抑制し、電極面積の減少を防止することができる。

【0091】これによって、半田接合形成の工程中のパンプ欠け不良を減少でき、接合形成後も良好な接合状態を維持し、耐熱疲労寿命の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る半田による接合方法について示す断面図(その1)である。

【図2】本発明の第1の実施の形態に係る半田による接合方法について示す断面図(その2)である。

【図3】本発明の第1の実施の形態に係る半田による接合方法について示す断面図(その3)である。

【図4】本発明の第1の実施の形態に係る半田パンプの形成方法について示す断面図である。

【図5】本発明の第1の実施の形態に係る半田パンプの形成方法におけるAu膜の膜厚と半田中のAuの含有量の相関関係について示すグラフである。

【図6】本発明の第2の実施の形態に係る半田による接合方法について示す断面図である。

【図7】従来例に係る半田による接合方法について示す断面図である。

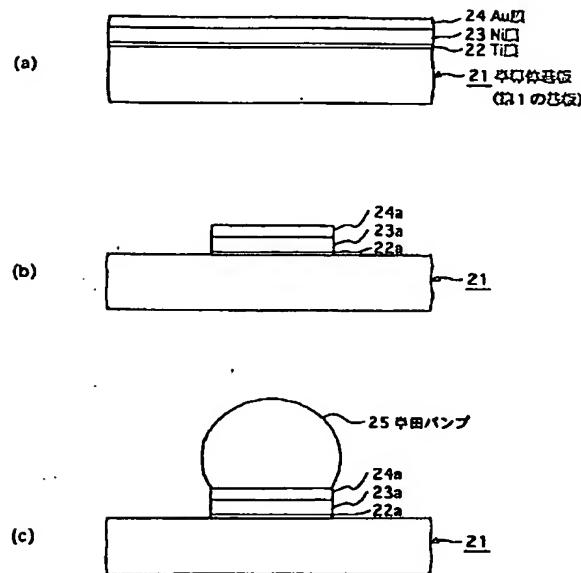
【符号の説明】

21, 41 半導体基板（第1の基板）
 23, 23a, 28, 43, 47 Ni膜
 24, 24a, 29 Au膜
 30a, 30b, 48a, 48b Sn-Ni化合物膜
 25 半田バンプ

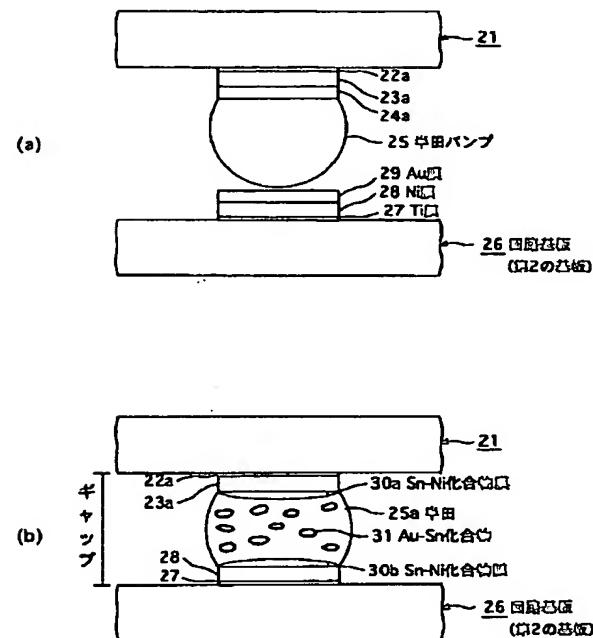
25a, 44a 半田

26, 45 回路基板（第2の基板）
 31 Au-Sn化合物
 31a, 31b, 49a, 49b Au-Sn化合物膜
 44 Au入り半田バンプ

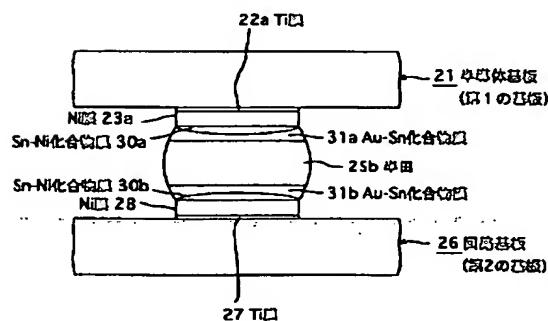
【図1】



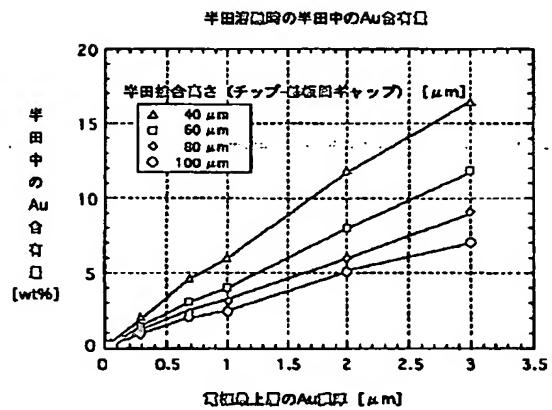
【図2】



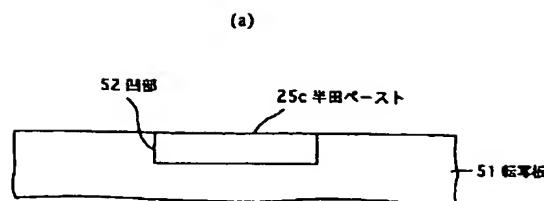
【図3】



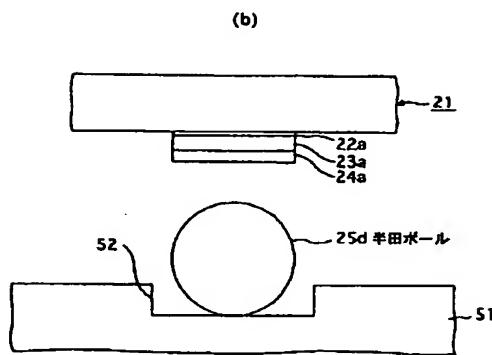
【図5】



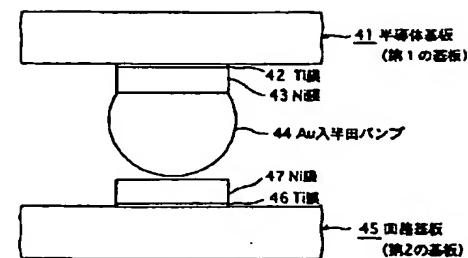
【図4】



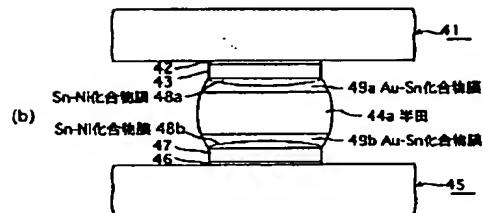
(a)



【図6】



(b)



【図7】

